\* 主要用途:

电子镇流器、节能灯、充电器及各类功率开关电路。

\* 主要特点:

硅三重扩散平面工艺、输出特性好、电流容量大。

\* 封装形式:

TO-126

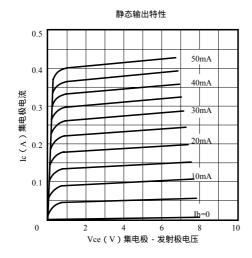
1. 基极 2. 集电极 3. 发射极

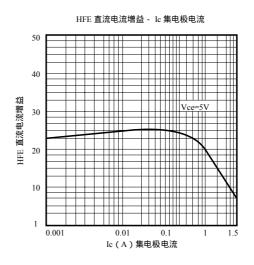
极限值:(Tc=25 )

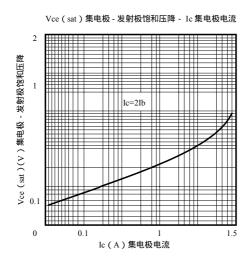
参数名称	符号	额定值	单 位
集电极 - 发射极击穿电压	BV <sub>CEO</sub>	400	V
集电极 - 基极击穿电压	BV <sub>CBO</sub>	600	V
发射极 - 基极击穿电压	BV <sub>EBO</sub>	9	V
最大集电极直流电流	Icm	1.5	A
最大耗散功率	Pcm	30	W
最高结温	Tjm	150	
贮存温度	Tstg	- 55 ~ 150	

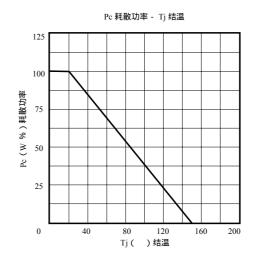
电特性: (Tc=25 )

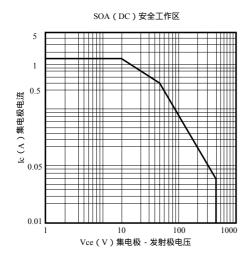
参数名称	符号	测 试 条 件	规范值		单位
多奴石 伽	1য 与		最小值	最大值	半 1
集电极 - 发射极击穿电压	$\mathrm{BV}_{\mathrm{CEO}}$	$I_C=1 \text{ mA}$ ; $I_B=0$	400		V
集电极 - 基极击穿电压	$\mathrm{BV}_{\mathrm{CBO}}$	$I_C=1 \text{ mA}$ ; $I_E=0$	600		V
发射极 - 基极击穿电压	$\mathrm{BV}_{\mathrm{EBO}}$	$I_E=1 \text{ mA}$ ; $I_C=0$	9		V
集电极 - 发射极反向漏电流	$I_{\text{CEO}}$	$V_{CE}$ =350V; $I_{B}$ =0		20	uA
集电极 - 基极反向漏电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}$ =550V; $I_E$ =0		10	uA
发射极 - 基极反向漏电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}$ =7V; $I_{C}$ =0		10	uA
共发射极直流电流增益	$H_{ ext{FE}}$	V <sub>CE</sub> =5V; I <sub>C</sub> =0.2A	10	35	
集电极 - 发射极饱和压降	V <sub>CE</sub> (sat)	$I_{C}=1A$ ; $I_{B}=0.5A$		0.6	V
下降时间	$\mathbf{t}_{\mathrm{f}}$	$I_{C}\!\!=\!1A$ ; $I_{B1}\!\!=\!I_{B2}\!\!=\!0.2A$ ; $V_{CE}\!\!=\!300V$		0.3	uS
特征频率	$f_{\scriptscriptstyle \mathrm{T}}$	$V_{CE}$ =10V ; $I_{C}$ =0.1A ; $f$ =1MHz		8	MHz



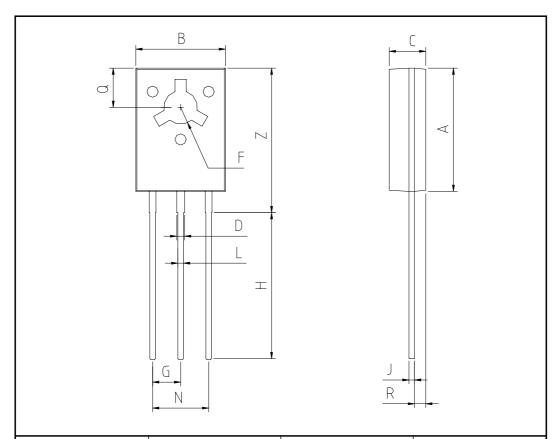








深圳市商岳电子有限公司



符号	最小值	典型值	最大值
A	9.0	10	11
В	7.05	8	8.05
С	2.4	2.5	2.8
D	1.4	1.5	1.6
F	3.15	φ3.2	3.25
G		2.3	
Н		13	
J	0.48	0.5	0.55
K			
L	0.65	0.75	0.85
N		4.6	
P			
Q	3.8	3.9	4.0
R	0.9	1	1.1
S			
Z	13.5	14	14.5